(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-232057

(43)公開日 平成9年(1997)9月5日

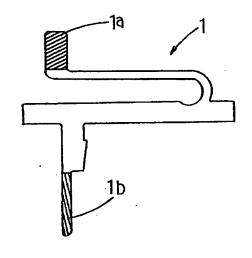
| (51) Int.Cl. ⁶ | 識別記号 庁 | 庁内整理番号 | FΙ | | 技術表示箇所 | |
|---------------------------|------------------|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| H01R 33/76 | | | H01R 3 | 33/76 | | |
| G01R 31/26 | | | G01R 3 | G01R 31/26 J | | J |
| H01L 23/32 | | | HO1L 2 | H 0 1 L 23/32 A | | |
| H 0 1 R 13/03 | | | H01R | 13/03 | D | |
| | | | 審查請 | 球 有 | 請求項の数1 | 書面(全 3 頁) |
| (21)出願番号 特顯平8-239653 | | (71) 出顧人 000208765 | | | | |
| | 実願平4-66682の変更 | | | | 社エンプラス | manest a E |
| (22)出顧日 | 平成4年(1992) 8月11日 | | (ma) representative | | 川口市並木2丁 | 自30番1号 |
| | • | | (72)発明者 | | | □00551 □ 11-1 A |
| | | | | | | 目30番1号 株式会 |
| | • | | (72)発明者 | - | ップラス内 av | |
| | | | (12)98914 | | | 目30番1号 株式会 |
| | | | | | がロルエネン・ グラス内 | DOMEST OF MINISTER |
| | | | | 社上ン | ZZAN | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(54) 【発明の名称】 I Cソケット

(57)【要約】

【目的】 I Cパッケージを装着して検査用回路基盤と前記ICパッケージとの電気的接続を行うI Cソケット において、前記I Cパッケージのリードに施されている 半田メッキと、前記I Cソケットのコンタクトピンの表面に施されている金メッキが化学的反応を起こして、電気抵抗の高い物質が前記コンタクトピンに付着することを防ぐ。

【構成】 前記コンタクトピンの接触部の表面を半田濡れ性が悪く電気抵抗の低い物質でメッキし、更に前記コンタクトピンの実装接続部の表面は金メッキをする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 リードに半田メッキを施した【Cパッケ ージを装着して、前記リードと回路基盤との電気的接続 を行わせるための、本体に多数のコンタクトピンを植設 したICソケットにおいて、少なくとも前記コンタクト ピンのリードとの接触部の表面は、半田濡れ性が悪く、 かつ電気抵抗の低い物質でメッキが施されており、更 に、少なくとも前記コンタクトピンの実装時の半田付け 接続部の表面は、金メッキが施されていることを特徴と するICソケット。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、ICバッケージを装着 して、前記ICパッケージのリードとICパッケージの 検査用回路との電気的接続をさせるためのICソケット に用いられるコンタクトピンに関する。

[0002]

【従来の技術】図4は、従来のフラット型ICパッケー ジ用のICソケットにICパッケージを装着した状態の ―例を示す断面図である。ソケット本体2に多数植設さ 20 れたコンタクトピンの実装接続部1bは、図示しない [Cパッケージの検査用回路基盤に半田付けされており、 コンタクトピンの接触部1a上に、ICパッケージのリ ード3aを載置することによって、ICパッケージ3と 前記回路基盤との電気的接続がなされる。

【0003】通常、ICパッケージのリード3aの表面 は半田メッキが施されている。また、コンタクトピン1 は通常、ベリリウム銅で作られており、その上にニッケ ルメッキを施し、更にその上に金メッキが施されてい

【0004】金メッキは、防食性に優れ、電気抵抗も低 く、半田付けもしやすい。しかし、金は高温下では、半 田と化学反応をしやすく、半田と結合して電気抵抗の高 い物質に変化してしまう。そのため、ICソケットを1 20℃~150℃の髙温下において使用する、所謂、バ ーイン試験等に長い間使用していると、リードの表面の 半田メッキとコンタクトピンの表面の金メッキが化学反 応を起とし、コンタクトピンの接触部に電気抵抗の高い 物質が付着して、ICバッケージの正しい検査ができな くなってしまう。

【0005】そこで、コンタクトピンの接触部1aに前 記の電気抵抗の高い物質がある程度付着してICバッケ ージの検査に支障が出たら、ブラシやサンドペーパーで コンタクトピンの接触部1aを擦って、前配の電気抵抗 の高い物質を除去していた。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】現在、ICパッケージ のリードは高密度に多数設けられているので、これに対 応して、ICソケットのコンタクトピンも高密度に多数 ソケット本体に植設されている。そのため、コンタクト 50 さらにその上に金メッキを全体に施す。最後に、金メッ

ビンの接触部に付着した前記の電気抵抗の高い物質をい ちいちブラシやサンドペーパーで擦って除去するのは、 大変な時間と労力を必要としていた。また、極端に薄い コンタクトピンの場合、ブラシやサンドペーパーでコン タクトピンを擦ると、コンタクトピンを変形させてしま うこともあった。

【0007】更に、多量に電気抵抗の高い物質がコンタ クトピンの接触部に付着してしまうと、ブラシやサンド ペーパーで擦っても取れなくなり、ICソケット自体を 10 破棄せざるを得なくなっていた。また、何度もコンタク トピンの接触部をブラシやサンドベーパーで擦っている と、コンタクトピンの接触部に施されていた金メッキと ニッケルメッキも一緒に取れてしまい、コンタクトピン として使用ができなくなり、やはり、ICソケット自体 を破棄しなければならなかった。

【0008】本発明は、ICバッケージのリードの表面 の半田メッキと、コンタクトピンの表面の金メッキが化 学反応を起こさないようにして、電気抵抗の高い物質が コンタクトピンの接触部に付着しないようにすることを 目的とする。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明は、ICソケット のコンタクトピンの接触部を、電気抵抗が低く、しか も、所謂、半田濡れ性の悪い物質でメッキし、コンタク トピンの実装接続部は金メッキを施すことによって、上 記の課題を解決する。

[0010]

【作用】半田濡れ性が悪いとは、化学的に半田との親和 性に乏しい為、半田との化学反応を開始しずらく、半田 30 との化合物を作りにくい性質のことである。上記のよう な性質を有する物質をコンタクトピンの接触部にメッキ することにより、コンタクトピンの接触部にICパッケ ージのリードを載置しても、リードの表面の半田メッキ と、コンタクトピンの表面の金メッキは接触しないの で、電気抵抗の高い物質ができることはない。

【0011】また、コンタクトピンの実装接続部は金メ ッキを施されているので、コンタクトピンの実装接続部 をICパッケージの検査用回路基盤に容易に半田付けで き、しかも前記回路基盤との接触抵抗も低くできる。

[0012] 40

【実施例】図1は、フラット型ICバッケージ用ICソ ケットに用いられるコンタクトピンの一例を示す正面図 である。図中、1はコンタクトピンで、斜線部1 a は I Cパッケージのリードと接触する接触部、斜線部1bは 1Cパッケージの検査用回路基盤に半田付けされること によって接続される実装接続部である。

【0013】ます、ベリリウム銅をブレス加工すること によって、図1に示すコンタクトピン1の形状に加工す る。次に、コンタクトピン1全体をニッケルメッキし、

3

キを施されたコンタクトピンの接触部1aの上のみ、または、コンタクトピンの実装接続部1bを除く部分全体に、半田濡れ性が悪く、しかも電気抵抗の低い物質、例えば、Ag-C, Au-Ni, Ni-B, Pd-P等の物質をメッキする。

[0014] あるいは、図1に示すコンタクトピン1の形状に加工し、コンタクトピン1全体にニッケルメッキを施した後に、上記に記載した半田濡れ性が悪い物質を、先にコンタクトピン1全体にメッキし、最後に、コンタクトピンの実装接続部1bのみ、または、コンタクトピンの接触部1aを除く部分全体に金メッキを施してもよい。

[0015] コンタクトピンの形状は、上記実施例に限定するものではなく、図2や図3に示すものなど、色々な種類の形状のコンタクトピンに本発明は適用できる。また、コンタクトピンの接触部1aにメッキする物質も、上記に記載したもの以外の物質でも、半田濡れ性が悪く、電気抵抗が低い物質ならば何でもよい。

[0016]

【発明の効果】コンタクトピンの接触部を、半田濡れ性 20 が悪く、電気抵抗が低い物質によってメッキしたことによって、ICパッケージのリードに施されている半田メッキと、コンタクトピンの接触部に施されたメッキが化 学反応することがなくなり、コンタクトピンの接触部に*

* 合金等が付着することが防げるので、コンタクトビンの 寿命が延び、ICソケットの髙寿命化が可能になり、し かも、ICパッケージのリードとコンタクトビンの接触 部との間の電気抵抗も低く押さえられる。

【0017】また、コンタクトビンの実装接続部は、従来と同じく金メッキを施してあるので、コンタクトビンの実装接続部の検査用回路基盤との半田付けのしやすさ、及び、コンタクトビンの実装接続部と検査用回路との接続部分での電気抵抗は、従来のままである。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に用いるコンタクトピンの一例を示す正 面図である。

【図2】本発明に用いるコンタクトビンの他の例を示す正面図である。

【図3】本発明に用いるコンタクトピンの第三の例を示す正面図である。

【図4】図1に示すコンタクトピンを植設したICソケットに、ICパッケージを装着した状態を示す断面図である。

【符号の説明】

1 コンタクトピン

1a コンタクトピンの接触部

1 b コンタクトビンの実装接続部

